

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2002093945 A**

(43) Date of publication of application: **29.03.02**

(51) Int. Cl.
H01L 23/12
H01L 23/29
H01L 23/31

(21) Application number: **2000281393**

(22) Date of filing: **18.09.00**

(71) Applicant: **IEP
TECHNOLOGIES:KKDEKUSUTAA
KK**

(72) Inventor: **KUWABARA OSAMU
WAKABAYASHI TAKESHI
GO ARASHI
SAGAMI YOSUKE**

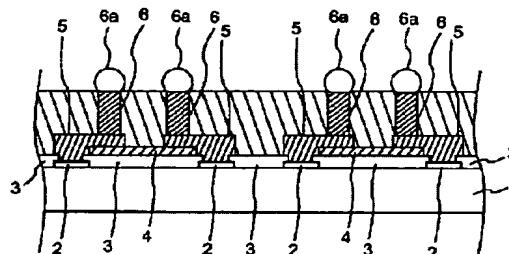
(54) **SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS
MANUFACTURING METHOD**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve a semiconductor device that can reduce the warpage of a wafer for improving a yield in wafer level CSP structure, and a method for manufacturing the semiconductor device.

SOLUTION: An insulating film 4, a sealing film 7, or an interlayer insulating film 10 is formed by a resin having modules of elasticity of 20 to 200 Kg/mm², thus greatly reducing the warpage of the wafer that has caused problems conventionally, and hence improving the yield in manufacture. As resin for achieving the low modules of elasticity, resin formed by curing a liquid bismaleic imide resin is formed. The formed resin has the low modules of elasticity, high heat resistance, and superhydrophobic characteristics, thus greatly improving reliability.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO



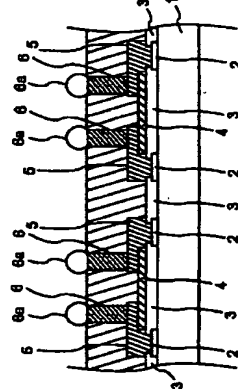
(51)Int.Cl. H01L 23/12	發明記号 501	F I H01L 23/12	501P 4M109 501C R	テロト [*] (参考)
23/28 23/31				
(21)出願番号	特願2000-281393(P2000-281393)	(71)出願人	5002/4531 株式会社アイ・イー・ピー・テクノロジーズ	審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全14頁)
(22)出願日	平成12年9月18日(2000.9.18)	(71)出願人	5630/0537 デクスター株式会社	
		(72)発明者	桑田 裕 東京都八王子市東浅川町550番地の1 株 式会社アイ・イー・ピー・テクノロジーズ内	
		(74)代理人	100098698 弁理士 鹿嶋 英貴	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置および半導体装置の製造方法

【57】【要約】

【課題】 ウェハレベルCSP構造において、ウェハの裏面を低減させて歩留まりを向上させることができる半導体装置およびその製造方法を実現する。

【解説平沼】 絶縁膜4、封止膜7あるいは層間絶縁膜10を低粘性率で20から200 K γ /mmの樹脂により形成することによって、従来の樹脂となっていたウエハの反りを大幅に低減させて、製造上の歩留まりを向上させる。この低粘性率を実現する樹脂として液状ビスマリイミナミ樹脂を硬化させて形成した樹脂を用いる。これにより形成した樹脂は、低粘性率、且つ、高耐熱性および耐湿水性の特性を有しているため、信頼性を大きく向上させることもできる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の接続パッドを備える半導体基板上に、前記複数の接続パッドを除く、前記半導体基板上に複数の接続パッドと、前記複数の接続パッドに接続された導線と、前記半導体基板上に設けられた複数の突起電極と、前記半導体基板上に設けられた複数の突起電極を除く前記半導体基板上ほぼ全体に設けられた絶止膜とを備えた半導体装置において、前記絶止膜が2.0から2.00K/mm²の樹脂にて形成され、弾性係数が2.0から2.00K/mm²の樹脂にて形成され、このことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記接続パッドに接続されて前記絶縁膜上に形成され、前記突起電極に接続される再配線を備えることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 複数の接続パッドを備える半導体基板上に、交互に複数の積層して形成された層間絶縁膜と前記接続パッドに接続される再配線と、前記再配線に接続してつけられた複数の突起電極と、該複数の突起電極を除く前記半導体基板上面ほぼ全体に設けられた封止膜とを備えた半導体装置において、

層覆された前記複数の層間絶縁膜および前記封止膜の厚さ、少なくともいずれか1つの膜を弾性率が20から2000Kg/mm2の樹脂にて形成したことを特徴とする導体装置。

【請求項4】 前記半導体基板の裏面側に、裏面ほぼ全表面を覆う、弾性率が20から200Kg/mm²の樹脂膜を備えることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の半導体装置。

【請求項5】 前記樹脂は、マレイン酸骨格を有すると
のいづれかに記載の半導体装置。

【請求項6】 前記液状ビスマレイミド樹脂には、少なくとも1種類の熱膨張係数低下用粒子が混入されていることを特徴とする請求項5に記載の半導体装置。

【請求項7】 複数の接続パッドを有するチップ形成領域を複数の備える半導体ウエハ基板上の、前記複数の接続パッドを除く半導体ウエハ基板上に絶縁膜を形成する工程と、

前記半導体ウエハ基板上に、前記複数の接続パッドに接
せられた複数の突起電極を形成する工程と、
前記複数の突起電極を除く前記半導体ウエハ基板上面ほ
う全体に、封止層を形成する工程と、

配半導体ウェハ基板を前記チップ形成領域毎に分析し、複数の半導体装置を形成する工程とを具備する半導体装置の製造方法において

配絶縁膜および封止膜のいずれか一方もしくは両方を、弾性率が20から200Kg/mm²の樹脂にて形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項8】 前記接続パッドに接続されて前記絶縁膜上に形成され、前記突起電極に接続される再配線を形成する工程を具備することを特徴とする請求項6に記載の工程を具備することを特徴とする。

半導体装置の製造方法

【請求項9】 複数の接続パッドを有するチップ形成領域を複数の電極を有する半導体ウェハ基板を制御する工程と、前記複数の電極を前記半導体ウェハ基板上に、前記接続パッドに接続される前記半導体ウェハ基板上に、前記接続パッドに接続される前記前記接続と回路接続を交互に複数回繰り返して形成する工程と、

前記再配線に接続された複数の突起電極を形成する工程と、

前記複数の突起電極を除く前記半導体ウェハ基板上面ほぼ全体に、封止層を形成する工程と、

前記半導体ウェハ基板を前記チップ形成領域毎に分断して複数の半導体装置を形成する工程とを具備する半導体装置の製造方法において、

積層される前記塩基の層間総縁膜および前記封止膜の内、少なくとも1つの膜を弾性率が20から200 KG/mm²の樹脂にて形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項10】 前記半導体ウェハ基板の裏面に、裏面全面にわたって、弾性率が 20 から 200 K G / m m ^2 の樹脂による裏面保護膜を形成する工程を具備することを特徴とする請求項7乃至9のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。

【請求項11】 前記封止膜が弾性率が20から200 K \times g/m 2 の樹脂にて形成された場合、その封止膜に前記突起電極を形成するための開口部をレーザー加工にて穿設する工程を具備することを特徴とする請求項7乃至9のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。

【図表項12】 前記複数の層間絶縁膜のうち、弾性率が2.0から200 K \cdot g/mm²の樹脂にて形成された層間絶縁膜に対して、その層間絶縁膜を挟んで対向する再入線同士を接続するための開口部を、レーザ加工にて当該層間絶縁膜に穿設する工程を具備することを特徴とする前記項9に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項13】 前記樹脂は、マレイン酸骨格を有する
 依次ビスマレインミド樹脂を硬化させることにより形成さ
 れていることを特徴とする請求項7乃至12のいずれか
 に記載の半導体素子の製造方法。

【請求項14】 前配液状ビスマレミド樹脂には、少なくとも1種類の熱膨張係数低下用粒子が混入されていることを特徴とする請求項13に記載の半導体装置の製造方法。

【發明の詳細な説明】

[0001]

【発明に属する技術分野】 本発明は、CSP (Chip Size Package) 構造の半導体装置およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、チップとパッケージのサイズがほぼ等しくなるCSP構造の半導体装置が知られており、その構造例を図18に示す。この図に示す半導体装置2

の中央部分が開口するよう絶縁膜4を形成する。

【0034】この絶縁膜4は、例えばウェハ1の回路面側全面にポリイミド系樹脂材を塗布硬化させた後に、エッチング液を用いてレジストパターンニングおよび絶縁膜パターンニングを施してからレジスト剥離することによって形成される。絶縁膜4は、ポリイミド系樹脂材を塗布してスパコン法による手法の他、スクリーンを用いる印刷法やノズルからのインク吐出による塗布法を用いることが可能であり、絶縁膜材料としてもポリイミド系樹脂材に限らず、エポキシ系樹脂材やPBO（ベンゾオキシベンゾ系）を用いても良い。

【0035】なお、上記絶縁膜4はウェハ1の回路面に、外部からの水分や不純物の侵入を防ぐことを主な目的として、信頼性を向上させるために設けられているものであるが、必ずしも必要なものではなく、絶縁膜4を上記パッシベーション膜3で代用できるようにしてもよい。その場合には、後述する再配線5や封止膜7はパッシベーション膜3上に形成される。

【0036】次に、図3（ロ）に図示するように、絶縁膜4に形成された開口部を介して露出される接続パッド2上に再配線5を形成する。再配線5は絶縁膜4の全面にUBMスパッタ処理等によりUBM層（図示略）を堆積し、その後、導体層用のフォトリソレジスト塗布硬化させ、フォトリソングラフ技術により所定形状の開口を有するパターンニングを施した後、このレジストによって開口された部分に電解メッキを施すことで形成される。再配線5を形成する手法としては、これ以外に無電解メッキ法を用いることもできる。配線材料としては、良好な導電性を備える銅、アルミおよび金あるいはこれらの合金を用いる。

【0037】再配線5を形成した後には、図3（ハ）に図示するように、各再配線5上の所定箇所にポスト（突起電極）6を設ける。ポスト6は、例えば100～150μm程度の厚さでポスト形成用のフォトリソレジストを塗布硬化させた上、再配線5の所定箇所を露出する開口部を形成し、この開口部内に電解メッキを施すことで形成される。ポスト6を形成する手法としては、これ以外に無電解メッキ法やスタッドバンプ法を用いることもできる。

【0038】ポスト材料は、良好な導電性を備える銅、ハンダ、金あるいはニッケル等を用いる。なお、ポスト形成材料としてはんだを用いる場合は、この後フロー処理を施す事により球状の電極を形成することも出来る。また、はんだを用いてポスト6を形成する場合に、上記の他に印刷法を用いることもできる。こうして、図3（ハ）に図示した構造が形成された後は、図4（イ）に図示するように、ポスト6を覆うように、ウェハ1の回路面全体に液状ビスマレイミド樹脂を塗布した後、硬化させて封止膜7を形成する。液状ビスマレイミド樹脂を塗布する手法としては、印刷法、浸漬法、スピン

インクウェハの反り量との関係を示したものである。ここで、従来のエポキシ樹脂の場合における弾性率は350～500K_g/mm²程度であり、このときの反り量は0.5mm程度である。また、フィラーを70%程度混入した場合の弾性率は2000K_g/mm²程度である。

【0029】これに対して、樹脂の弾性率が十分に小さい、20～80K_g/mm²の場合には、反り量は0.1μm程度しか発生せず、実質的には反りが殆ど無いに等しい状態とすることができると見出した。そして、このような低い弾性率を実現できる樹脂材料として、液状ビスマレイミド樹脂を硬化させることによって形成した樹脂が適用できることを見出した。

【0030】この液状ビスマレイミド樹脂とは、マレイン酸骨格を有する樹脂であり、また、従来、同種の樹脂は固体でのみ得られていたが、これを液状化することによって、スパコン法、印刷、ディスペンサ等の方法により塗布可能としたものである。なお、この液状ビスマレイミド樹脂を硬化させて形成した樹脂では、熱膨張率調整のためのフィラーを混入させた場合も弾性率の増加は小さく、フィラーを70%程度混入させた場合でも弾性率は2000K_g/mm²程度であり、その場合の反り量は5μm以下となり従来のエポキシ樹脂を用いた場合と比べて、反り量は1/400程度となり、格段に小さくすることができる。

【0031】このように、本発明は、封止膜や絶縁膜等の樹脂膜に用いる樹脂材料の弾性率を十分小さい値にすることによって、ウェハの反り量を大幅に低減させるようになることである。以下に示す各実施形態は、上記樹脂膜を形成する材料として液状ビスマレイミド樹脂を用いるようにしたものである。

【0032】＜第1の実施形態＞図2～図4は、第1の実施形態による半導体装置20の構造およびその製造工程を説明する断面図である。これらの図において前述した従来例（図18参照）と共通する部分については同一の番号を付し、その説明を省略する。第1の実施形態による半導体装置20は、図2に図示する通り、図18に図示した従来例と同一の構造を有している。このような構造において液状ビスマレイミド樹脂を封止膜7の樹脂として用い、それを塗布硬化して封止膜7を形成するようにしたものである。

【0033】次に、図3～図4を参照して、第1の実施形態による半導体装置20の製造工程について説明する。先ず図3（イ）に図示する通り、ウェハ1の回路面に設けられたアルミ電極等からなる複数の接続パッド2の上面側、それぞれ各接続パッド2の中央部を露出するよう、酸化シリコンあるいは酸化シリコン等からなる絶縁膜をパッシベーション膜3として形成する。この後、パッシベーション膜3の上面側に各接続パッド2

ザ照射によって容易に加工できる特性を有している。そこで、液状ビスマレイミド樹脂を封止膜7に用いる場合に、この特性を利用して、以下のように、開口部の形成にレーザ加工を適用するようにしたものである。

【0044】まず、図5（イ）、（ロ）に図示するように、ウェハ1の回路面側に設けられたアルミ電極等からなる複数の接続パッド2の上面側、パッシベーション膜3、絶縁膜4および再配線5を形成した後、図5（ハ）に示すように、ウェハ1の回路面全体にビスマレイミド樹脂を塗布、硬化させて封止膜7を形成する。この後、図6（イ）に示すように、レーザ加工によって封止膜7にポスト形成用の開口部を所定箇所に複数形成し、続いて図6（ロ）に示すように、その形成したポスト形成用の開口部にポスト形成材を充填してポスト6を形成する。この場合、UBM層を介した電解メッキを用いることができないので、蒸着、無電解メッキ、スタッドバンプ形成法、はんだボール格納法あるいはハンダ材充填などの手法によりポスト6を形成することになる。

【0045】このように、レーザ加工にてポスト6を形成する変形例では、フォトリソが不要となるため、コスト低減を図ることが可能になる。また、レーザの照射位置、ビーム幅およびビーム強度を制御するだけで所望のポスト形成用の開口部を複数し得るので、迅速に対応が可能となり、品種変更にも容易に対応可能となる。加えて、レーザ加工はドライプロセスであるため、薬液の管理や廃液処理を省くことができ、工程管理も容易になる。

【0046】＜第2の実施形態＞図7は、第2の実施形態による半導体装置20の構造を示す断面図であり、上述した第1の実施形態（図2参照）と同一の構造を有している。第2の実施形態による半導体装置20が、第1の実施形態と相違する点は、パッシベーション膜3の上の面に各接続パッド2の中央部分が開口するよう形成される絶縁膜4の材料にビスマレイミド樹脂を用いたことにある。

【0047】この場合、絶縁膜4は、例えばウェハ1の回路面側全面に液状ビスマレイミド樹脂を塗布硬化させた後に、エッチング液を用いてレジストパターンニングおよび絶縁膜パターンニングを施してからレジスト剥離することによって形成される。液状ビスマレイミド樹脂を塗布することでは、ウェハ1の回路面側に設けられたアルミ電極等からなる複数の接続パッド2の上面側、パッシベーション膜3、絶縁膜4および再配線5を形成した後、図5（ハ）に示すように、ウェハ1の回路面全体にビスマレイミド樹脂を塗布、硬化させて封止膜7を形成する。この後、図6（イ）に示すように、レーザ加工によって封止膜7にポスト形成用の開口部を所定箇所に複数形成し、続いて図6（ロ）に示すように、その形成したポスト形成用の開口部にポスト形成材を充填してポスト6を形成する。この場合、UBM層を介した電解メッキを用いることができないので、蒸着、無電解メッキ、スタッドバンプ形成法、はんだボール格納法あるいはハンダ材充填などの手法によりポスト6を形成することになる。

【0048】絶縁膜4をビスマレイミド樹脂にて形成すると、従来用いていたポリイミド系樹脂材に比べて吸水率が低くなる為、信頼性向上に寄与できる。また、従来用いていたポリイミド系樹脂材に比べて熱膨張係数が低

く、しかもビスマレイミド樹脂は低弾性率材なので、ウエハ1全体に生じる反り量を抑えるのに有効である。さらに、レーザ加工にて絶縁膜4をパターンニングすることが可能になるので、フォトマスクが不要となり、コストが低減を図ることも可能になる。また、レーザの照射位置、ビーム幅およびビーム強度を制御するだけで所望のパターンニングを施せるから、迅速な対応が可能となり、品種変更に対応可能となる。加えて、レーザ加工はドライプロセスだから、薬液の管理や廃液処理を省くことができ、工程管理も容易になる。

【0049】＜第3の実施形態＞図8は、第3の実施形態による半導体装置200の構造を示す断面図であり、上述した第1の実施形態（図2参照）と同一の構造を有している。第3の実施形態による半導体装置200が、第1の実施形態と相違する点は、封止膜7および絶縁膜4の両方をビスマレイミド樹脂にて形成したことにある。この場合、絶縁膜4は、上述した第2の実施形態と同様、スパコンコート法、印刷、ディスペンサ法あるいはダイコート法等によってウエハ1の回路側面に液状ビスマレイミド樹脂を厚さ5～10 μ m程度塗布し、それを硬化させてからエッチングやレーザ加工でパターンニングを形成する。封止膜7は、上述した第1の実施形態と同様、ウエハ1の回路面全体にビスマレイミド樹脂を塗布した後、硬化させて形成する。

【0050】絶縁膜4および封止膜7の両者をビスマレイミド樹脂にて形成すると、従来絶縁膜4に用いていたポリイミド系樹脂材や、封止膜7に用いていたエポキシ樹脂に比べて一段と弾性率を低減させることができるため、より一層ウエハ1全体に生じる反り量を抑えることができるようになる。さらに、吸水率を大きく低下させることができるため、信頼性をさらに向上させることができる。また、レーザ加工にて絶縁膜4をパターンニングしたり、封止膜7にポスト形成用の開口部を穿設し得るので、フォトマスクが不要となり、コスト低減を図ることも可能になる。さらに、レーザの照射位置、ビーム幅およびビーム強度を制御するだけで所望のパターンニングを施せるから、迅速な対応が可能となり、品種変更にも容易に対応可能となる。加えて、レーザ加工はドライプロセスであるため、薬液の管理や廃液処理を省くことができ、工程管理も容易になる。

【0051】＜第4の実施形態＞図9～図11は、第4の実施形態による半導体装置200の構造およびその製造工程を説明するための断面図である。これらの図において前述した第1の実施形態（図2参照）と共通する部分には同一の番号を付し、その説明を省略する。第4の実施形態による半導体装置200が、図9に図示した第1の実施形態と相違する点は、ウエハ1の裏面側にビスマレイミド樹脂を用いた裏面保護膜8を形成したことにある。

【0052】こうした第4の実施形態の製造工程について図10～図11を参照して説明する。先ず図10

絶縁膜4および封止膜7の両者をビスマレイミド樹脂にて形成すると共に、ウエハ1の裏面（背面）側をビスマレイミド樹脂の裏面保護膜8で覆うようにしたので、ウエハ1全面に生じる反り量や吸水率を極めて低減でき、しかも高弾性率をも具備する結果、信頼性向上を図ることが可能になる。これに加えて、裏面保護膜8がウエハ1の背面側を透光するので、外光入射による半導体装置200の回路の駆動動作を抑制することも可能になる。さらに、裏面保護膜8を形成する際に、ウエハ1を切削研磨してその厚さを薄くすることで、半導体装置200の厚さの増加を抑えるとともに、ウエハ1の熱歪み等によるクラック発生を抑えることが出来、これにより熱ストレスに対する信頼性も向上する。

【0057】＜第5の実施形態＞図12～図14は、第5の実施形態による半導体装置200の構造およびその製造工程を説明するための断面図である。これらの図においては同一の番号を付し、その説明を省略する。第5の実施形態と相違する点は、図12に図示するように、第1の再配線5上にビスマレイミド樹脂を用いた周囲絶縁膜10を形成して多層構造にしたことにある。なお、第1の再配線5と周囲絶縁膜10上に形成される第2の再配線12とはビアポスト11にて電気的に接続される。

【0058】上記構造において、絶縁膜4、周囲絶縁膜10および封止膜7を全てビスマレイミド樹脂にて形成すれば、ウエハ1全体に生じる反り量や吸水率を極めて低減でき、しかも高弾性率をも具備でき、しかもこうし多層構造では第1の再配線5もしくは第2の再配線12を所定形状にパターンニングして導線素子や受動素子などの受動素子を設けることも可能なるから、半導体装置200の寸法を増加させることなく多機能とすることができるとともに、高信頼性の半導体装置200を具現し得る。

【0059】次に、図13～図14を参照して第5の実施形態の製造工程について説明する。先ず図13（イ）に図示する通り、ウエハ1の回路側面に設けられたアルミ電極等からなる複数の接続パッド2の上面側に、それぞれ各接続パッド2の中央部を露出するように、酸化シリコンあるいは酸化シリコン等からなるパッシベーション膜3を形成する。この後、パッシベーション膜3の上面に各接続パッド2の中央部分が開口するよう絶縁膜4を形成する。

【0060】絶縁膜4は、ウエハ1の回路側面に液状のビスマレイミド樹脂材を塗布硬化させた後に、エッチング液を用いてレジスタパターンニングおよび絶縁膜パターンニングを施してからレジスタ剥離することで形成される。絶縁膜4は、ビスマレイミド樹脂材を塗布してスパコンコートする手法の他、スクレージを用いた印刷法やノズルからのインク吐出による塗布法を用いることが可

能である。

【0061】次に、図13（ロ）に図示するように、絶縁膜4に形成された開口部を介して露出される接続パッド2上に第1の再配線5を形成する。第1の再配線5は、絶縁膜4の全面にUBMスパッタ処理等によりUBM層（図示略）を堆積し、この後、導体層用のフォトリソリッドを露光させ、フォトリソグラフィ技術により所定形状の開口を有するパターンニングを施した後、このレジストによって開口された部分に電解メッキを施すことで形成される。再配線5を形成する手法としては、これ以外に無電解メッキ法を用いることもできる。配線材料としては、良好な導電性を備える銅、アルミおよび金あるいはこれらの合金を用いる。

【0062】再配線5を形成した後には、図13（ハ）に図示するように、各再配線5上の所定箇所にてビアポスト11を設ける。ビアポスト11は、ポスト形成用のフォトリソリッドを塗布硬化させた上、再配線5の所定箇所を露出する開口部を形成し、この開口部に電解メッキを施すことで形成される。ビアポスト11を形成する手法としては、これ以外に無電解メッキ法やスタッドバンプ法を用いることもできる。ポスト材料は、良好な導電性を備える銅、ハンダ、金あるいはニッケル等を用いる。なお、ポスト形成材料としてははんだを用いる場合は、この後リフロー処理を施す事により球状の電極を形成することも出来る。また、はんだを用いてポスト6を形成する場合には、上記の他に印刷法を用いることもできる。

【0063】こうして、図13（ハ）に図示した断面構造が形成された後は、図14（イ）に図示するように、ビアポスト11を覆うように、ウエハ1の回路面全体をビスマレイミド樹脂を塗布、硬化させて周囲絶縁膜10を形成する。この後、周囲絶縁膜10上の所定箇所にて第2の再配線12を形成する。第2の再配線12を形成した後には、各再配線12上の所定箇所にポスト6を設ける。

【0064】図14（ロ）に図示した構造が形成された後は、図14（ハ）に図示するように、ポスト6を覆うように、ウエハ1の回路面全体にビスマレイミド樹脂を塗布、硬化させて封止膜7を形成する。封止膜7を形成した後は、封止膜7の上面端を切削研磨してポスト6の端面を露出させ、その表面の酸化膜を取り除き、そこにハンダ印刷等のメタライズ処理を施すが、あるいはパンドボール6aを形成する。この後、予め定められたカットラインに沿ってウエハ1をダイシングしてチップに個片化することによって、図12に図示した構造の半導体装置200が生成される。

【0065】＜第5の実施形態の変形例＞次に、図15～図17を参照して第5の実施形態の変形例による半導体装置200の製造工程について説明する。この変形例による製造工程が上述した第5の実施形態と相違する点

(9)

は、レーザ加工にてビアポスト1.1およびポスト6を形成するための開口部を穿設することにある。すなわち、図15(イ)、(ロ)に図示するように、ウェハ1の回路面側に設けられたアルミ電極等からなる複数の接続パッド2の上側に、パッシベーション層3、絶縁膜4および平坦膜5を形成した後、図15(ハ)に示すように、ウェハ1の回路面全体に液状のビスマスレイド樹脂を塗布硬化させて層間絶縁膜10を形成する。

【0068】この後、図15(ハ)に示すように、レーザ加工によって層間絶縁膜10にビアポスト形成用の開口部を所定箇所に着設穿設し、続いて図16(イ)に示すように、その穿設したビアポスト11を形成する。この場合、UBM層を介して電解メッキを用いることができないうで、蒸着、無電解メッキあるいはハンダ材充填などの手法によりビアポスト11を形成することになる。

【0069】続いて、図16(ロ)に示すように、このビアポスト11に電気的に接続されるウェハ1の回路面全体に層間絶縁膜10に形成した後、ウェハ1の回路面全体に液状のビスマスレイド樹脂を塗布硬化させて封止膜7を形成する。そして、図17(ハ)に示すように、レーザ加工によって封止膜7にビアポスト形成用の開口部を所定箇所に着設穿設し、続いて図17(ロ)に示すように、その穿設したビアポスト形成用の開口部にビアポスト形成材料を充填してビアポスト6を形成する。この場合、UBM層を介して電解メッキを用いることができないうで、蒸着、無電解メッキあるいはハンダ材充填などの手法によりビアポスト6を形成することになる。

【0068】このように、レーザ加工にてビアポスト1およびビアポスト6を形成する変形例では、フォトマスクが不要となるため、コスト低減を図ることが可能になる。また、レーザの照射位置、ビーム幅およびビーム強度を制御するだけで所望のビアポスト形成用の開口部を穿設し得るので、迅速な対応が可能となり、品種変更に対応可能となる。また、レーザ加工はドライプロセスであるため、薬液の管理や廃液処理を省くことができ、工程管理も容易になる。なお、上述した各実施形態では、十分に小さい弾性率を得ることができ、樹脂としては、液状ビスマスレイド樹脂によって形成した樹脂を用いることとしたが、本発明はこれに限定されるものではなく、同じく小さい弾性率を得ることができ、樹脂であれば同様に適用できるものである。

【0069】

【発明の効果】請求項1、7に記載の発明によれば、絶縁膜および封止膜のいずれか一方もしくは両方を、弾性率が200から2000Kg/mm²の樹脂に形成したものである。従来問題となっていたウェハの反りを大幅に低減することができ、請求項3、9に記載の発明によれば、積層された複数の層間絶縁膜の内、少なくとも一つは、1つの膜を弾性率が200から2000Kg/mm²の樹脂

にて形成するので、積層された複数の層間絶縁膜を備える構造においても、従来問題となっていたウェハの反りを大幅に低減することができる。請求項4、10に記載の発明によれば、弾性率が200から2000Kg/mm²の樹脂にて形成される表面保護膜で半導体基体の表面側を覆うことで、ウェハの反りを低減できるとともに、表面側が遮光されて、外光入射によるチップ回路の動作を抑制することができ、請求項5、6および請求項13、14に記載の発明によれば、前記樹脂としてマレイン酸骨格を有する液状ビスマスレイド樹脂を硬化させて形成した樹脂を用い、この樹脂は低弾性率であるとともに、耐湿性および耐熱性に優れた特性を備えている。ウェハの反りを大幅に低減できるとともに、信頼性を大きく向上させることができる。更に、熱膨張係数低下用粒子を混入して用いた場合においても、ウェハの反りの低減および信頼性の向上を図ることができ、請求項11に記載の発明によれば、前記封止膜が弾性率が200から2000Kg/mm²の樹脂にて形成された場合、その封止膜に前記突起電極を形成するための開口部をレーザ加工にて穿設するので、フォトマスクが不要となり、コスト低減を図ることができ、また、レーザの照射位置、ビーム幅およびビーム強度を制御するだけで、迅速な対応が可能となり、品種変更に対応可能となる。また、レーザ加工はドライプロセスであるため、薬液の管理や廃液処理を省くことができ、工程管理を容易にすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】ウェハの反り量と樹脂の弾性率の関係を示すグラフである。

【図2】第1の実施形態による半導体装置20の構造を示す断面図である。

【図3】第1の実施形態による製造工程を説明するための断面図である。

【図4】図2に続く製造工程を説明するための断面図である。

【図5】第1の実施形態の変形例による製造工程を説明するための断面図である。

【図6】図4に続く変形例による製造工程を説明するための断面図である。

の断面図である。

【図7】第2の実施形態による半導体装置20の構造を示す断面図である。

【図8】第3の実施形態による半導体装置20の構造を示す断面図である。

【図9】第4の実施形態による半導体装置20の構造を示す断面図である。

【図10】第4の実施形態による製造工程を説明するための断面図である。

【図11】図9に続く製造工程を説明するための断面図である。

【図12】第5の実施形態による半導体装置20の構造を示す断面図である。

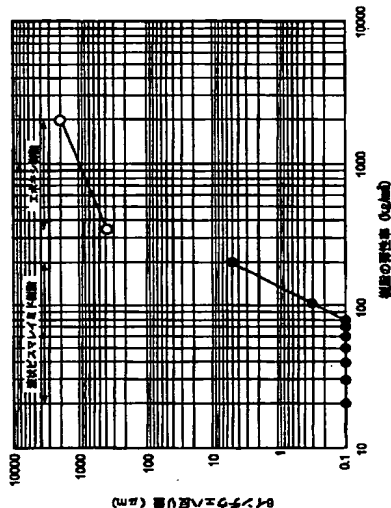
【図13】第5の実施形態による製造工程を説明するための断面図である。

【図14】図12に続く製造工程を説明するための断面図である。

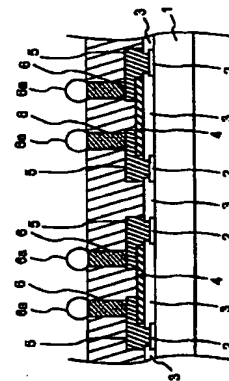
【図15】第5の実施形態の変形例による製造工程を説明するための断面図である。

【図16】図14に続く変形例による製造工程を説明する

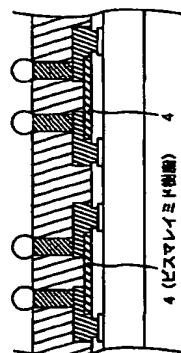
【図1】



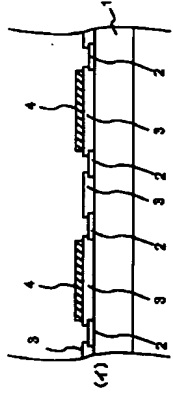
【図2】



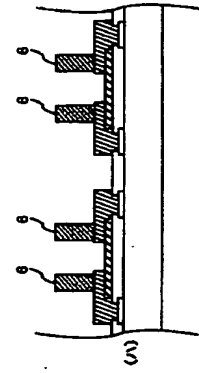
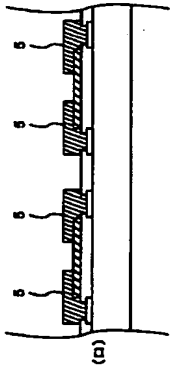
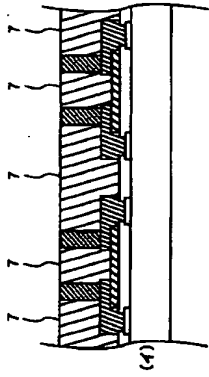
【図7】



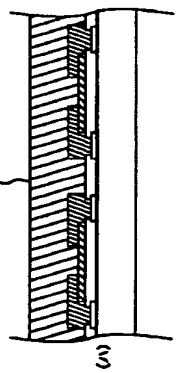
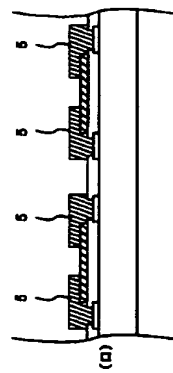
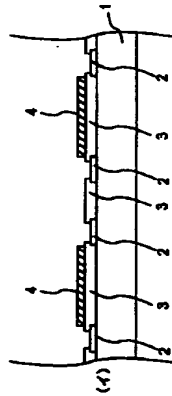
【図3】



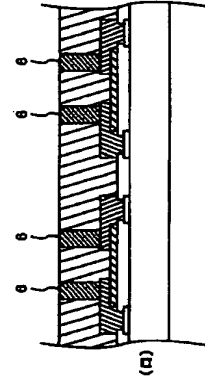
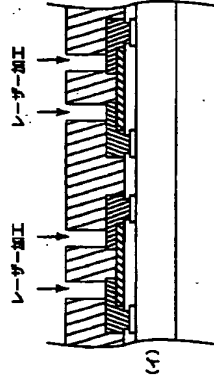
【図4】



【図5】



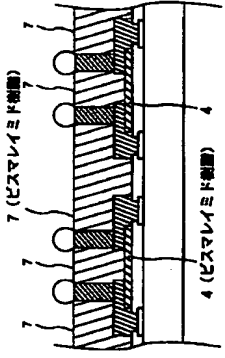
【図6】



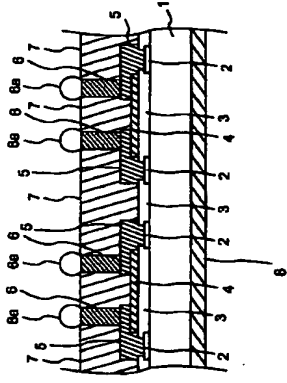
【図19】



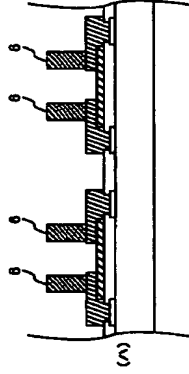
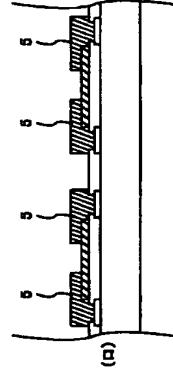
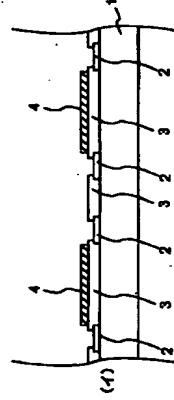
【図8】



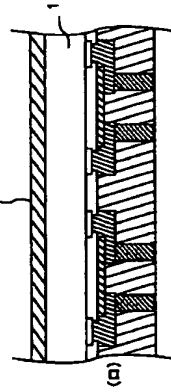
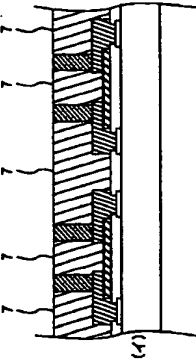
【図9】



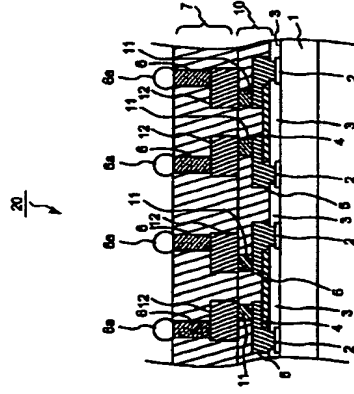
【図10】



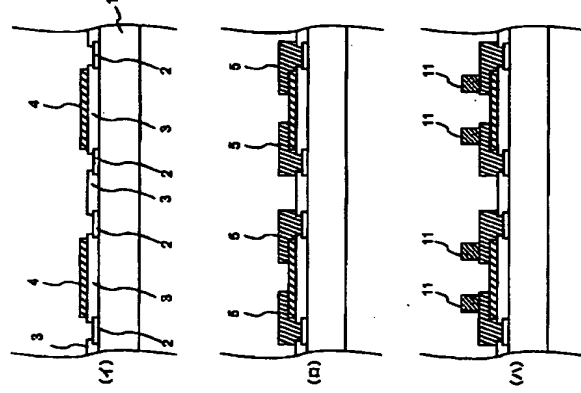
【図11】



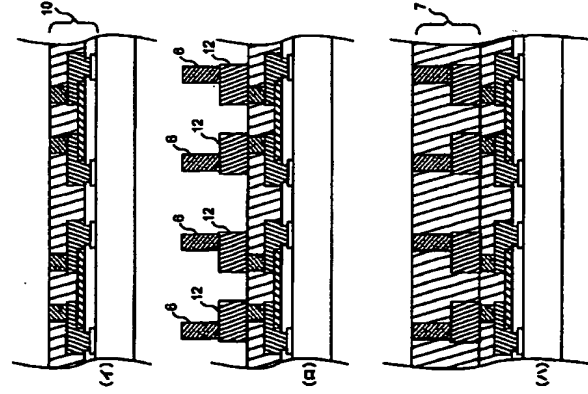
【図12】



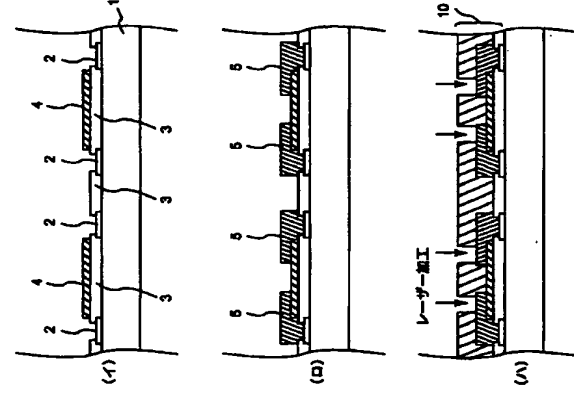
【図13】



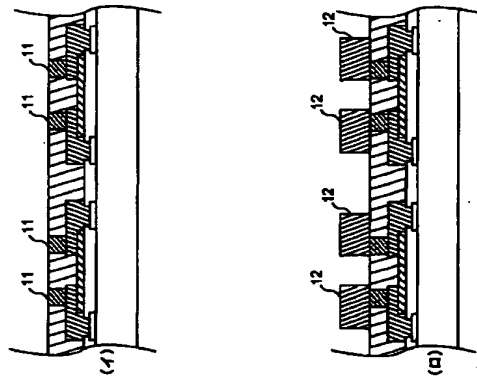
【図14】



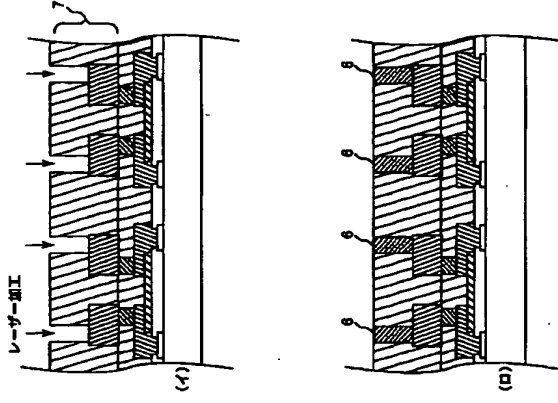
【図15】



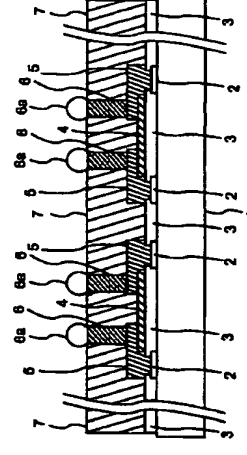
【図16】



【図17】



【図18】



フロントページの続き

(72)発明者 若林 隆
東京都八王子市東浅川町550番地の1 株
式会社アイ・イー・ピー・テクノロジーズ
内

(72)発明者 呉 風

神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2050番地
デクスター株式会社内

(72)発明者 佐上 洋祐

神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2050番地
デクスター株式会社内

Fターム(参考) 4M109 A02 BA05 CA05 CA12 EA07
EB13 EB14 EC04 ED03 EE02